19 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-118093

@Int_Ci_

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和63年(1988)5月23日

C 25 D 5/18

7325-4K

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

❸発明の名称

電子部品の錫めつき方法

②特 願 昭61-264216

愛出 願 昭61(1986)11月5日

⑫発 明 者 小 林

幸青

東京都三腐市下連省8-5-1 田中電子工業株式会社三

腐工場内

⑪出 願 人

田中電子工業株式会社

東京都中央区日本橋茅場町2丁目6番6号

20代 理 人 弁理士 早川 政名

明 郜 🖺

1. 発明の名称

電子部品の題めっき方法

2. 特許額求の短四

被めっき物に対して正電流を通電させてするで、数なめっきの工程中に、数なめっき物に対して配換の極性を逆転させた逆電流を周期的に通路してめっきをするめっき方法において、前記正電流の電流密度を 0.2 A/d n ~ 3 A/d n ~ 3 A/d n ~ 3 面間(t 1)を 1~50秒とし、逆電流の電流密度を 0.1 A/d n ~ 3 面間(t 2)を (0.01 ~ 0.5) t ,秒としてめっきをする電子部品の組めっき方法。

3. 発明の詳細な説明

(産泉上の利用分野)

本発明はメモリー 1 C 及びプリント基板等の 電子部品のめっき方法に関するものである。 (従来の技術とその問題点)

/ NE SK OD DC WAY C C OD HOLDS IN A

超子都品等に施しためっきの裏面には、いわ ゆるひげ(ホイスカー)が発生し、これらがち 密な配線間等の権政しをして短絡現象を引き起 すことが認められ、進大な問題となっている。

そこで、これらのひけの発生を防止するため に想に5%以上の鉛を含有させ、或いはゼラチン等の磁加物を含有させてめっきをしていた。

ところが、給を含有させるとめっき後の半田のぬれ性が悪く、且つ鉛の排水処理が公審問題となる歌れがあり、また、ゼラチン等の窓加加物はあっき後の使用の原に、該家加物が然に、めいのではない。そのではないのではがありた。そのでは、いいかのはないというの原去には吸良の方法ではなかった。

(発明が解決しようとする技術的課題)

以上の問題を解決するための本発明の技術的 課題は、電子部品のめっき中に発生するひげを 防止することである。

(技術的課題を達成するための技術的手段)

また、逆電流の電流密度が 0.1 A/d 元未満だとひげの発生の防止に寄与せず、 1.5 A/d 元を

整液器(3)は被めっき物(2)にめっきを 施すために錫板(1)と被めっき物(2)とに 通電するためのものであり、図中においては2 つ示されているが、これは鍋板(1)が被めっ き物(2)の両側に設置される傷合に使用される。

本発明においては片側一方に設置されているので、1つの整族器を使用する場合について説明する。

切換スイッチ(S)はタイマー付きであり、電流を錦板(1)から被めっき物(2)に通電する正電流(M)と、被めっき物(2)から錫板(1)に通電させる逆電流(N)との通常方向の切換えを行なうものであり、タイマーによりこれら正電波(M)及び逆電流(N)の通常時間が設定される。

而して、本発明の電気めっきは電解液(m)を選择させながら正電流(M)を 0.2 A/d m~3 A/d mの範囲内の電流密度で、通電時間(ti)が 1~50秒の範囲内で通電すると共に、

越えると光沢が出すぎるため電子部品としての 半田ぬれ性が悪くなる。

また、逆電流の通電時間が 0.01 t」未満だとひげの発生の防止に寄与せず、 0.5t」を越えると光沢が出すぎて、電子部品としての半田のぬれ性が悪くなる。

(発明の効果)

本発明は以上の様な方法としたことにより、 電子部品に施しためっきの表面にひげが発生す るのを防止することができる。

(宴施與)

以下本発明の一実施例を図面により説明する。 図中(A)は電解液(m)を満した傷めっき 用の器解槽である。

(1) は電解精製により一定の純度に精製された場板であり、切換スイッチ(S) を介して 整旗器(3) に連結されている。

(2)は電子部品等の被めっき物であり、錫 板(1)と同様に切換スイッチ(S)を介して 整波器(3)に連結されている。

該正電流 (M) の通電中に切換スイッチ (S) の切換により逆電流 (N) が 0.1 A/d n ~ 1.5 A/d n の範囲内の電流密度で、通電時間 (t) が (0.01 ~ 0.5) t い かの範囲内で通電される。

また、これら正電流(M)と逆電流(N)との通電回数は通知時間により設定され、例えば、正電流(M)が50秒に対して逆電流が10秒の場合は1サイクル/分(B')となり、正電流が1秒に対して逆電流が 0.5秒の場合は40サイクル/分(B)に設定される。

これは、被めっき物(2)へのめっき厚さに 応じて任意に設定される。

以上の様な正理流(M)の電流密度及び通難時間(tı)。逆電流(N)の電流密度及び通電時間(tı)の範囲内においては電子部品に施した鋼めっきの表面にはひげの発生がみられない。

次の表は、本発明の方法により電気めっきを 施してひげの発生の有無の測定した 県を示す ものである。

特開昭63-118093(3)

2

	テスト	街 解		*		Ħ	20 12	放隘	サン	% 12	
		Œ	寋	淀	浬	3	81	TOTAL-		プル	ホイスカー
	Ю	Ndw	H	回数	No 4	Ø	図数	時間(分)	(5)	散	発生率
	1	1.5	0.5	40	0. 15	2	39	20	30°C	64	0/64
	2	1.5	0.5	40	0. 15	5	39	20	30.0	34	0/64
実	3	1.0	0.5	60	0.1	2	59	30	30 <i>C</i>	64	0/64
	4	1.5	0.5	40	Q. 15	2	39	20	30°C	64	0/64
塘	5	2.0	0.5	30	0.2	2	29	15	30°C	64	0/64
JPS	6	2.5	0.5	20	0.25	2	19	10	30°C	64	0/64
	7	1.0	0.5	60	0.1	5	59	30	30°C	64	0/64
8	8	1.5	0.5	40	0.15	5	39	20	301C	64	0/64
	9	2.0	0.5	30	0.2	5	29	15	30.C	64	0/64
	10	2.5	0.5	20	0.25	5	19	10	30°C	64	0/84
比較	Θ	1.0	_	-		-	_	40	30 . C	64	38/64
₩ ₩	2	2.0	-	-	-	_	_	20	30 . C	64	64/64

以上の様な結果から、本発明の効果、卸ち知めっきの表面にひげが発生しないことを確認することができた。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の電気めっきの電解槽の断面図、第2図は電波密度の正電液及び逆電流の過電時間を示すね図である。

尚、図中

(M):正電流

(N):逆電流

を夫々示す。

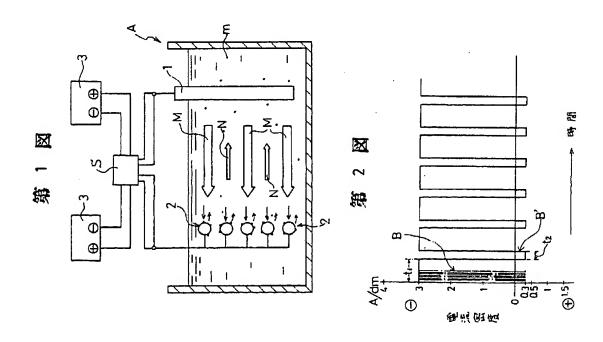
特許出國人

田中電子工業株式会社

代理人

早 川 i





.

METHOD FOR TINNING ELECTRONIC PARTS

Patent Number:

JP63118093

Publication date:

1988-05-23

Inventor(s):

KOBAYASHI KOKICHI

Applicant(s):

TANAKA ELECTRON IND CO LTD

Requested Patent: JP63118093

Application Number: JP19860264216 19861105

Priority Number(s):

IPC Classification:

C25D5/18

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE: To inhibit the formation of whiskers on the tinned surfaces of electronic parts by supplying electric current between an electrode plate of metallic Sn and the electronic part to be tinned in a tinning soln. in opposite directions with a specified period.

CONSTITUTION:A tinning soln. (m) is poured in a tinning cell A and an electrode late 1 of metallic Sn and electronic parts 2 to be tinned are immersed in the soln. (m). The polarity of power sources is changed over with a change-over switch S fitted with a timer. Normal electric current M flowing from the Sn electrode 1 to the parts 2 is first supplied at 0.2-3A/dm<2> current density for t1 sec and then reverse electric current N flowing from the parts 2 to the Sn electrode 1 is supplied at 0.1-1.5A/dm<2> current density for (0.01-0.5)t1 sec. The parts 2 are tinned by repeatedly supplying the normal and reverse electric currents and the formation of whiskers on the resulting Sn layers on the surfaces of the parts 2 is prevented.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

